

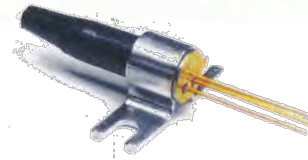
高線形同軸PD(1/2)

特長

- 高線形InGaAs PinフォトダイオードはアナログO/E変換アプリケーションに最適です。
- 低容量、低反射減衰量、低暗電流、低混変調歪み
- ミニ同軸寸法
- オプションでシングルモードやマルチモードのファイバ、コネクタの取り付け可能
- また、フランジの取り付けも可能

アプリケーション

- アナログCATV/CDMAレシーバー
- 3.5GHzブロードバンドアナログレシーバー
- 多チャンネルファイバ光伝送システム



絶対最大定格

項目	単位	最小	最大
動作温度	°C	-40	85
保管温度	°C	-40	85
湿度	%	-	95
逆バイアス電圧	V	-	20
ダイオード電流	mA	-	10
逆流電流	mA	-	10
Lead Soldering 温度	°C	-	260
Lead Soldering 時間	s	-	10
出力	mW	-	3
Fiber yield strength	N	-	10
曲げ半径	mm	30	-
ファイバ長	mm	900	1100

仕様

項目	単位	最小	代表値	最大	試験条件
動作電圧	V	0	15	20	
Distortion Product IM2	dBc	-	-	-70	VR=15V, Pavg=0dBm, MI=0.4, R=50Ω f1=505MHz, f2=55MHz
Distortion Product IM3	dBc	-	-	-80	
暗電流	nA	-	-	1	
端子間容量	pF	-	-	0.5	
-3dB Bandwidth	GHz	3.5	-	-	50Ω
波長	nm	1100	-	1650	
応答	1310	A/W	0.85	-	λ = 1310, Vbias = -5V, Pi = 0dBm
	1310	A/W	0.80	-	λ = 1310, Vbias = 0V, Pi = 0dBm
	1550	A/W	0.90	-	λ = 1550, Vbias = -5V, Pi = 0dBm
	1550	A/W	0.85	-	λ = 1550, Vbias = 0V, Pi = 0dBm
反射減衰量	dB	45	-	-	λ = 1310nm & 1550nm